

Title (en)
SUBCOLLECTOR FOR BIPOLAR TRANSISTORS.

Title (de)
BIPOLARE TRANSISTOREN MIT VERGRABENER KOLLEKTORSCHICHT.

Title (fr)
SOUS-COLLECTEUR POUR TRANSISTORS BIPOLAIRES.

Publication
EP 0244452 A1 19871111 (EN)

Application
EP 86906377 A 19861020

Priority
GB 8525848 A 19851019

Abstract (en)
[origin: GB2181889A] A method of fabricating bipolar transistors which comprises the steps of producing on a silicon substrate of one conductivity type silicon, a collector shunt (22) of cobalt disilicide or of any other material having a good lattice match to silicon and compatible with conventional silicon integrated circuit processes, subsequently growing epitaxially on to said collector shunt and substrate a layer (18) of opposite type conductivity silicon and subsequently forming by conventional techniques the base (10) emitter (11) and collector (8, 12) regions of the transistor in the epitaxially grown layer of silicon.

Abstract (fr)
Procédé de fabrication de transistors bipolaires consistant à produire sur un substrat en silicium d'un type déterminé de conductivité une dérivation de collecteur (22) en bisiliciure de cobalt ou tout autre matériau présentant une bonne correspondance avec le réseau cristallin du silicium et compatible avec les procédés conventionnels de production de circuits intégrés en silicium, à provoquer par la suite sur la dérivation du collecteur et sur le substrat la croissance épitaxiale d'une couche (18) en silicium présentant une conductivité de type opposé et à former ensuite par des techniques conventionnelles les régions de base (10), d'émetteur (11) et de collecteur (8, 12) du transistor dans la couche de silicium obtenue par croissance épitaxiale.

IPC 1-7
H01L 21/74; **H01L 21/20**; **H01L 21/76**

IPC 8 full level
H01L 21/20 (2006.01); **H01L 21/331** (2006.01); **H01L 21/74** (2006.01); **H01L 21/761** (2006.01)

CPC (source: EP)
H01L 21/02381 (2013.01); **H01L 21/02491** (2013.01); **H01L 21/02532** (2013.01); **H01L 21/02573** (2013.01); **H01L 21/74** (2013.01); **H01L 21/761** (2013.01); **H01L 29/66272** (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 8702510A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
GB 2181889 A 19870429; **GB 8525848 D0 19851120**; EP 0244452 A1 19871111; WO 8702510 A1 19870423

DOCDB simple family (application)
GB 8525848 A 19851019; EP 86906377 A 19861020; GB 8600643 W 19861020